

โปรแกรมวิเคราะห์ทรานเซียนต์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นแบบท่อน



นาย ธเนศ สุวงศ์

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529

ISBN 974-566-641-6

013525

I15829908

A Transient Analysis Program for Piecewise Linear Electronic Circuits

Mr. Thanet Suvongse

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering

Department of Electrical Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1986

ISBN 974-566-641-6

หัวข้อวิทยานิพนธ์  
โดย  
ภาควิชา  
อาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมวิเคราะห์ทรานเซียนต์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นแบบท่อน  
นาย ธเนศ สุวงศ์  
วิศวกรรมไฟฟ้า  
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย พิศาลบุตร)  
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ปฏิบัติราชการแทนรักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... *Dr. A. J.* ..... ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไททม อารียา)

..... *Dr. S.* ..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรียัน ดิษยาธิคม)

..... *Dr. K.* ..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์)

..... *Dr. E.* ..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์      โปรแกรมวิเคราะห์ทรานเซียนต์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นแบบท่อน  
ชื่อนักศึกษา      นาย ธเนศ สุวงศ์  
อาจารย์ที่ปรึกษา      รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาภิรมย์  
ภาควิชา      วิศวกรรมไฟฟ้า  
ปีการศึกษา      2528



บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้กล่าวถึง การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบบนไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับคำนวณทรานเซียนต์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นแบบท่อนทั่วไป วงจรดังกล่าวอาจจะประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ แหล่งกำเนิดแรงดัน แหล่งกำเนิดกระแส ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ และสวิตช์ โปรแกรมนี้เขียนขึ้นด้วยภาษาเบสิก ผู้ใช้สามารถป้อนรายละเอียดของวงจรได้ง่ายโดยใช้ภาษาที่โปรแกรมกำหนดขึ้น โปรแกรมนี้ผ่านการทดสอบได้อย่างน่าพอใจกับวงจรประเภทต่างๆ ได้แก่ วงจรขยาย วงจรชนิดทรานซิสเตอร์ วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เป็นต้น

วิธีเชิงเลขต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แก่ วิธีโมดิไฟดไนต์ล สำหรับสร้างสมการวงจรอย่างมีระบบ วิธีแยกตัวประกอบแอล-ยู สำหรับแก้สมการเมตริก วิธีประมาณอนุพันธ์เวลาของตัวแปรสถานะของวงจร และเทคนิคสำหรับปรับขนาดขั้นเวลาโดยอัตโนมัติ

ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และออปแอมป์ เป็นอุปกรณ์ไม่เชิงเส้นที่ถูกประมาณด้วยวงจรสมมูลเชิงเส้นแบบท่อน อุปกรณ์เหล่านี้ แต่ละตัวจะมีการทำงานได้หลายภาวะ แต่ละภาวะการทำงานจะตรงกับวงจรสมมูลเชิงเส้นซึ่งแตกต่างกันไป เทคนิคต่างๆ ที่ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ ถูกพัฒนาขึ้นใหม่เองทั้งสิ้น และสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์เชิงเส้นแบบท่อนชนิดอื่นๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ ยูนิจังก์ชันทรานซิสเตอร์ ซีเนอร์ไดโอด เป็นต้น

ผลจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้ศึกษา และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งชนิดเชิงเส้น และชนิดเชิงเส้นแบบท่อน



## กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินการวิจัยนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย สีสารัมภ์ ที่ได้กรุณาให้แนวความคิด พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการดำเนินงานวิจัยนี้ ตลอดจนให้การสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้การวิจัยนี้ได้รับผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการพิมพ์และจัดรูปเล่มจนเป็นที่เรียบร้อย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	ง
กิตติกรรมประกาศ .....	ช ญ
สารบัญภาพ .....	
บทที่	
1. บทนำ .....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
1.2 งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .....	2
1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย .....	3
1.4 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงานวิจัย .....	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย .....	3
1.6 เนื้อหาโดยย่อของวิทยานิพนธ์ .....	4
2. การวิเคราะห์ท่วงจรด้านทานเชิงเส้น .....	6
2.1 การจำแนกประเภทวงจร .....	6
2.2 การสร้างสมการวงจรด้วยวิธีไมติฟายด์ไนตัล .....	7
2.3 ตราประจำอุปกรณ์ .....	9
2.4 การแก้สมการเมตริกด้วยวิธีแยกตัวประกอบแอล-ยู .....	10
3. การวิเคราะห์ท่วงจรพลาวัตเชิงเส้น .....	12
3.1 บทนำ .....	12
3.2 ตราประจำอุปกรณ์แบบอนุพันธ์ของตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ... ..	12
3.3 การแก้สมการของวงจรถ่วงพลาวัตด้วยวิธีเชิงเลข .....	14
3.4 ตราประจำอุปกรณ์แบบพีชคณิตของตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ... ..	17
4. การวิเคราะห์ท่วงจรพลาวัตเชิงเส้นแบบท่อน .....	20
4.1 ลักษณะสมบัติเชิงเส้นแบบท่อน .....	20
4.2 ตราประจำอุปกรณ์ของไดโอด .....	22
4.3 ตราประจำอุปกรณ์ของออปแอมป์ .....	23
4.3.1 ตราประจำอุปกรณ์ของออปแอมป์ในภาวะไงานงาน .....	23
4.3.2 ตราประจำอุปกรณ์ของออปแอมป์ในภาวะอิ่มตัว .....	24

สารบัญ(ต่อ)

บทที่

หน้า

4.4	ตราประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์.....	27
4.4.1	ตราประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์ในภาวะไวงาน..	27
4.4.2	ตราประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์ในภาวะย้อนกลับ.	28
4.4.3	ตราประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์ในภาวะอิ่มตัว...	29
4.4.4	ตราประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์ภาวะไม่นำกระแส	30
4.4.5	ตราประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์เมื่อใช้ตัวแปร แบบบูล .....	32
4.5	ตราประจำอุปกรณ์ของสวิตช์ .....	33
4.6	การสร้างและแก้สมการวงจรเชิงเส้นแบบท่อน .....	34
4.7	การตรวจสอบภาวะการทำงานของอุปกรณ์เชิงเส้นแบบท่อน...	35
4.7.1	ไดโอด .....	36
4.7.2	ออปแอมป์ .....	37
4.7.3	ทรานซิสเตอร์ .....	38
4.7.4	สวิตช์ .....	39
5.	การปรับขนาดขั้นเวลาอัตโนมัติ .....	40
5.1	ประโยชน์ของการใช้ขนาดขั้นเวลาที่เปลี่ยนได้อย่าง เหมาะสม .....	40
5.2	ความหมายของ LTE (Local Truncation Error).....	42
5.3	การเลือกขนาดขั้นเวลาโดยใช้ LTE .....	43
5.4	LTE ของอุปกรณ์พลวัต .....	44
6.	โปรแกรมต้นแบบสำหรับวิเคราะห์วงจรเชิงเส้นแบบท่อน.....	49
6.1	บทนำ .....	49
6.2	โครงสร้างโปรแกรมและโมดการทำงานของ "TAPE" .....	50
6.3	ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งานในโมด INPUT .....	51
6.4	คำสั่ง EDIT .....	53
6.4.1	ตัวต้านทาน .....	55
6.4.2	ตัวเหนี่ยวนำ .....	56
6.4.3	ตัวเก็บประจุ .....	57
6.4.4	สวิตช์ .....	58
6.4.5	ทรานซิสเตอร์ .....	59
6.4.6	ค่าพารามิเตอร์ประจำเบอร์ทรานซิสเตอร์ .....	61



สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
6.4.7	62
6.4.8	63
6.4.9	64
6.4.10	65
6.4.11	66
6.4.12	67
6.5	68
6.6	70
6.6.1	70
6.6.2	75
7.	76
7.1	76
7.2	82
7.3	84
7.4	86
7.5	90
7.6	92
7.7	94
7.8	96
8.	98
8.1	98
8.2	99
เอกสารอ้างอิง	100
ประวัติ	101

สารบัญภาพ

รูปที่		หน้า
1.1	ตัวอย่างวงจรที่สามารถวิเคราะห์ได้.....	2
2.1	ตัวอย่างของวงจรต้านทาน .....	6
2.2	ตัวอย่างของวงจรพลวัต .....	7
2.3	ตัวอย่างวงจรที่ไม่สามารถใช้วิธี Node Analysis สร้างสมการโดยตรงได้ .....	8
2.4	ตารางสมการเมตริกของวงจรในรูปที่ 2.3 .....	9
2.5	ตราประจำอุปกรณ์ .....	9
	(ก) แหล่งกำเนิดแรงดัน .....	9
	(ข) แหล่งกำเนิดกระแส .....	10
	(ค) ความต้านทาน .....	10
2.6	โครงสร้างเมตริกแบบ .....	11
	(ก) Lower Triangular .....	11
	(ข) Upper Triangular .....	11
3.1	ตัวอย่างของวงจรพลวัตเชิงเส้น .....	12
3.2	ตราประจำอุปกรณ์แบบอนุพันธ์ของตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ .....	13
3.3	สมการของวงจรพลวัตเชิงเส้นในรูปที่ 3.1 .....	14
3.4	ตัวอย่างของวงจรพลวัตที่มีจำนวนตัวแปรสถานะน้อยกว่า จำนวนตัวแปรที่มีอนุพันธ์ในสมการวงจร .....	15
3.5	ตัวอย่างของสมการเมตริกของวงจร RLC ที่ได้จากการ ประมาณอนุพันธ์ .....	16
3.6	การแก้สมการอนุพันธ์-พีชคณิตที่เวลา $t=0$ ถึง $t=T$ โดย วิธีคณิตศาสตร์เชิงเลข .....	17
3.7	ตัวเหนี่ยวนำที่ผ่านการประมาณอนุพันธ์ .....	18
	(ก) วงจรสมมูล .....	18
	(ข) ตราประจำอุปกรณ์แบบพีชคณิต .....	18

## สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่

	หน้า
3.8 ตัวเก็บประจุที่ผ่านการประมาณอนุพันธ์แล้ว .....	19
(ก) วงจรสมมูล .....	19
(ข) คราประจําอุปกรณ์แบบพีชคณิต .....	19
4.1 ลักษณะสมบัติของไดโอด .....	20
(ก) ไม่เชิงเส้น .....	20
(ข) เชิงเส้นแบบท่อน .....	20
4.2 ตัวอย่างของวงจรเชิงเส้นแบบท่อน .....	21
4.3 ลักษณะสมบัติเชิงเส้นแบบท่อนของไดโอด .....	22
4.4 ไดโอดขณะไม่นํ้ากระแส .....	22
(ก) วงจรสมมูล .....	22
(ข) คราประจําอุปกรณ์ .....	22
4.5 ไดโอดขณะนํ้ากระแส .....	23
(ก) วงจรสมมูล .....	23
(ข) คราประจําอุปกรณ์ .....	23
4.6 คราประจําอุปกรณ์ของไดโอด เมื่อใช้ตัวแปรแบบบูล เข้าช่วย .....	23
4.7 ลักษณะสมบัติของฟังก์ชันโอนย้ายของออปแอมป์ .....	24
4.8 วงจรสมมูลของออปแอมป์ .....	24
4.9 คราประจําอุปกรณ์ของออปแอมป์ในภาวะไวงาน .....	25
4.10 วงจรสมมูลของออปแอมป์ในภาวะอิมิตัว .....	26
(ก) ทางบวก .....	26
(ข) ทางลบ .....	26
4.11 คราประจําอุปกรณ์ของออปแอมป์ในภาวะอิมิตัวแล้ว .....	26
4.12 วงจรสมมูลแบบไฮบริด .....	27
4.13 วงจรสมมูลแบบ Ebers-Moll .....	28
4.14 ลักษณะสมบัติเชิงเส้นแบบท่อนของไดโอดที่รอยต่อ PN .....	28
4.15 วงจรสมมูลของทรานซิสเตอร์ในภาวะไวงาน .....	29
(ก) วงจรสมมูล .....	29
(ข) วงจรที่ใช้งาน .....	29
4.16 คราประจําอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์ในภาวะไวงาน .....	29
4.17 วงจรสมมูลของทรานซิสเตอร์ในภาวะไวงานย้อนกลับ .....	30

## สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

4.18	ตารางประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์ในภาวะไวงานย้อนกลับ.....	30
4.19	วงจรสมมูลของทรานซิสเตอร์ในภาวะอิ่มตัว.....	31
4.20	ตารางประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์ในภาวะอิ่มตัว.....	31
4.21	วงจรสมมูลของทรานซิสเตอร์ในภาวะไม่นำกระแส.....	32
4.22	ตารางประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์ในภาวะไม่นำกระแส.....	32
4.23	ตารางประจำอุปกรณ์ของทรานซิสเตอร์.....	33
4.24	ลักษณะสมบัติของสวิตช์.....	33
	(ก) วงจรสมมูล.....	33
	(ข) สมบัติการทำงาน.....	33
4.25	ตารางประจำอุปกรณ์ของสวิตช์แบบสองทาง.....	34
4.26	ตัวอย่างการวิเคราะห์วงจรเชิงเส้นแบบท่อน.....	35
4.27	การตรวจภาวะการทำงานของไดโอด.....	36
4.28	ลักษณะสมบัติไอน์ย่ายของออปแอมป์.....	37
4.29	ลักษณะสมบัติเชิงเส้นแบบท่อนของรอยต่อ PN.....	38
5.1	ตัวอย่างการคำนวณวงจร RC ที่ใช้ h คงที่.....	41
5.2	แสดงจุดเวลาในการคำนวณวงจรรูป 5.1(ก) เมื่อให้ h เปลี่ยนแปลงได้.....	42
5.3	ลักษณะทางเรขาคณิตของการคำนวณค่า $LTE_{n+1}$ .....	43
5.4	แสดงการปรับขนาดขั้นเวลากับการปรับค่า $V_{n+1}$ .....	47
6.1	โครงสร้างหลักของโปรแกรม 'TAPE'.....	50
6.2	แสดงการเก็บข้อมูลของไดโอด.....	51
6.3	การแสดงผลบนจอภาพในโหมด INPUT.....	53
6.4	ข้อมูลบนจอภาพเมื่อเข้าสู่โหมด EDIT.....	54
6.5	การป้อนข้อมูลของไดโอด.....	54
	(ก) ไดโอด D1อยู่ในโหมดนำกระแส.....	54
	(ข) การป้อนข้อมูลของไดโอด.....	54
6.6	การใส่ข้อมูลของความต้านทาน.....	55
	(ก) การแสดงผลบนจอภาพ.....	55
	(ข) การจัดข้อมูลใน array.....	55
6.7	การใส่ข้อมูลของตัวเหนี่ยวนำ.....	56

## สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

6.8	การใส่ข้อมูลของตัวเก็บประจุ.....	57
6.9	การใส่ข้อมูลของสวิตช์.....	58
6.10	การใส่ข้อมูลของทรานซิสเตอร์.....	60
6.11	การใส่พารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์.....	61
6.12	การใส่ข้อมูลของออปแอมป์.....	62
6.13	การใส่พารามิเตอร์ของออปแอมป์.....	63
6.14	การใส่ข้อมูลของไดโอด.....	64
6.15	การใส่พารามิเตอร์ของไดโอด.....	65
6.16	การใส่ข้อมูลของแหล่งกำเนิดแรงดัน.....	67
6.17	การจัดข้อมูลของแหล่งกำเนิดกระแส.....	67
6.18	เมนูของคำสั่ง CHANGE .....	68
6.19	ลักษณะการแสดงผลข้อมูลวงจร.....	69
6.20	ไฟล์เวิร์กการทํางานในโหมด 'SIM'.....	71
6.21	การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพเมื่อเข้าโหมดวิเคราะห์วงจร.....	72
6.22	โครงสร้างการโหลดข้อมูลในเมตริก A.....	72
6.23	แสดงการโหลดข้อมูลในเมตริก B.....	73
6.24	โครงสร้างการเก็บผลข้อมูลในเมตริก SM.....	74
6.25	การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพในโหมดเอาต์พุต.....	74
6.26	การแสดงผลทางจอภาพเมื่อ LIST RESULT และ PRINT RESULT.....	75
7.1	วงจรกรอง.....	77
	(ก) วงจรกรองผ่านต่ำ.....	77
	(ข) วงจรกรองผ่านสูง.....	77
7.2	กราฟผลการวิเคราะห์.....	78
	(ก) วงจรกรองผ่านต่ำในรูปที่ 7.1(ก).....	78
	(ข) วงจรกรองผ่านสูงในรูปที่ 7.1(ข).....	79
7.3	วงจร RLC.....	80
7.4	กราฟผลการวิเคราะห์วงจร RLC ในรูปที่ 7.3.....	81
7.5	วงจรกรองผ่านต่ำที่มีการเปลี่ยนค่า time constant ทันที...82	
7.6	กราฟผลการทดลองวงจรกรองผ่านต่ำในรูปที่ 7.5.....	83
7.7	วงจรรขยายสัญญาณต่าง.....	84
7.8	ผลการทดลองวงจรรขยายสัญญาณต่างในรูปที่ 7.7.....	85
7.9	วงจรรขยายออปแอมป์.....	86
7.10	กราฟผลการวิเคราะห์วงจรรขยายที่ใช้ออปแอมป์ในรูปที่ 7.9...87	

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

7.11	วงจรทดลองผลตอบสนองเชิงเวลาเนื่องจากความถี่ที่กมม.....	88
7.12	กราฟผลการทดลองวงจรออปแอมป์ในรูปที่ 7.11.....	89
7.13	วงจรมิตต์ทริกเกอร์.....	90
7.14	กราฟผลการทดลองวงจรมิตต์ทริกเกอร์.....	91
7.15	วงจรออสซิลเลเตอร์.....	92
7.16	กราฟผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจรในรูปที่ 7.15.....	93
7.17	วงจรขยายไฟตรง.....	94
7.18	กราฟผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจรในรูปที่ 7.17.....	95
7.19	วงจรเอกะเสถียร.....	96
7.20	กราฟผลการวิเคราะห์วงจรในรูปที่ 7.19.....	97



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย